dấu hiệu $R_{AD} = R_{chùm} + R_0 = 794$, độ lệch và cáp Itanox $C_0 = 54 \text{ NF và}$ C ₁ = 70 pf đã được đo lường Sử dụng bộ phân tích trở kháng ở mức 1 .26 MHz. Thiết bi đầu cuối T3 và T4 được nối đất. Một sự mất tập trung 1 m tâm Điện áp Bu er er fi er được sử dụng để giảm thiểu các tác phẩm của cáp và máy phân tích phổ trên opera đông cơtion. Trong hình 3b dc gia nhiệt điện trở có thể dẫn đến một nhiệt độ tăng cường của chùm tia chống lại sự làm mớicơ chế xây dưng. Nó được ước tính từ nhiệt đôsự phụ thuộc của sức đề kháng và từ FEM sim-Nhiễm trùng rằng nhiệt độ tối đa của động cơ chùm là 370 \pm 20 K và $\tau \hat{o}_{1,3} = 3$ mA (xem bổ sung quá sung. C). Nhiệt đô này tăng 17% bằng DC hệ thống sưởi ấm tương đối nhỏ so với yếu tố

5 đã ra lệnh trong T , Kết quả của việc giảm Q Chúng tôi cảm ơn J.J.M. Ruigrok, C.S Vaucher, K. Reimann, R. Woltjer và E.P.A.M. Bakkers cho các cuộc thảo luân và Sug-Gestions và cảm ơn J. V. Wingerden vì sư hỗ trợ của anh ấy với các phép đo SEM. Các tác giả tuyên bố rằng Ho không có lợi ích tài chính canh tranh. Tác giả con-K.L.P., P.G.S., J.T.M.V.B. và M.J.G. TRONGthông hơi và thiết kế thiết bị. P.G.S., K.L.P., M.J.G. và C.V.D.A. thực hiện các thí nghiệm. P.G.S. sư phát triểnops the lý thuyết, phân tích các thí nghiệm và viết J.T.M.V.B., G.E.J.K. và G.J.A.M.V. không đúng veloped công nghệ quy trình và sản xuất Phó. Được gửi đến P.G.S. (Peter.steeneken@nxp.com).

1 Epstein, A. H. MILIMARTER-Kích thước, cơ điện tử cơ điện Hệ thống động cơ tuabin khí. J. Eng. Tua bin khí năng lượng 126 , 205 bóng226 (2004). $_2$ Jacobson, S. A. & Epstein, A. H. Một cuộc khảo sát không chính thức về quyền lực MEMS . Int. Symp. Micro-mech. Eng. (Ismme) PK18 (2003) ₃ Spadaccini, C. M. & Waitz, I. A. Toàn diên microsys-Tem , chap. 3.15 C-Callingtion (Elsevier, Amsterdam, 4 Peterson, R. B. Giới han kích thước cho động cơ nhiệt tái tạo. Kỹ thuật vật lý nhiệt nano và kính hiển vi 2 . $^{121}_{5}$ bóng131 (1998). $_{5}$ Wil fi nger, R. J., Bardell, P. H. & Chhabra, D. S. Các Resonistor: một thiết bị chon lọc tần số sử dụng mecộng hưởng chanical của chất nền silicon. IBM J. Res. Dev. 12 , 113 bóng117 (1968). 6 Elwenspoek, M. et al. Cơ chế tải nap và Ứng dụng của họ trong các thiết bị vi mô. Proc. IEEE MEMS 126 Từ 132 (1989) , Lammerink, T., Elwenspoek, M. & Fluitman, J. Tần số Sự phụ thuộc của sự kích thích nhiệt của cơ học vi mô Onators. Sens. Hành động. MỘT 25 trận 27 , 685 bóng 689 (1991). 8 Nhìn, H. et al. Nhiệt kim loại từ tính fl exure bộ truyền động. Hội thảo cảm biến trạng thái rắn IEEE và bộ truyền động 5 , 73 trận 75 (1992) 9 Reichenbach, R. B., Zalalutdinov, M., Parpia, J. M. & Rf mems Craighead, H. G. Dao động với tích hợp 27 , 805 bóng807 Điện trở. IEEE ELEL Dev. L. (2006). 10 SEO, J. H. & Brand, O. High Q. -In-plane-chế đô dân cư. Nền tảng Microsensor cho môi trường khí/lỏng. J. Mems 17 , 483 bóng493 (2008). 11 Cohadon, P., Heidmann, A. & Pinard, M. Làm mát a Gương bằng áp suất bức xạ. Vật lý. Rạn san hô. Lett. 83 , 3174... 3177 (1999) 12 Metzger, C. H. & Karrai, K. Làm mát khoang của một microlever. , Thiên nhiên 432 , 1002 bóng 1005 (2004), Arcizet, O., Cohadon, P.-F., Briant, T., Pinard, M. & Hei-Dmann, A. Làm mát áp suất bức xạ và cơ học Sự không ổn định của micromirror. từ nhiên 444 71 bóng 74 (2006). 14 Kleckner, D. & Bouwmeester, D. Làm mát quang học Sub-Kelvin

của một bộ cộng hưởng vị mô. tư nhiên 444 , 75 bóng78 (2006). $_{15}$ Schliesser, A., Del hè Haye, P., Nooshi, N., Vahala, K. J. &

Kippenberg, T. J. Làm mát áp suất bức xạ của microme-

Bộ tạo dao động Chanical sử dụng mặt sau động. Vât lý. Rev. Lett. 97 , 243905 (2006). Brown, K. R. et al. 13 et al. Làm mát thụ động của một cơ học vi mô dao động với mạch điện cộng hưởng. Vật lý. Rạn san hô. Lett. 99 , 137205 (2007). 17 Metzger, C., Favero, I., Ortlieb, A. & Karrai, K. F am dam- P khoang erot trong cal tư làm mát của một biến dạng Giới hạn cổ điển. Vật lý, Mục sư b. 78, 035309 (2008) 18 Teufel, J., Donner, T., Castellanos-Beltran, M. A., Harlow, J. & Lehnert, chuyển động cơ học nano được đo bằng một sư thiếu chính xác dưới đây ở giới han lượng tử tiêu chuẩn. Công nghệ nano thiên nhiên 4 820 bóng823 (2009). 19 Feynman, R. P., Leighton, R. B. & Sands, M. , tâp. Tôi, Ch. 46 (Addison-Wesley, người đàn ông giảng bài về vật lý Đọc, 1963) ₂₀ Spadaccini, C. et al. Đốt cháy silicon mật đô cao Hệ thống cho động cơ tuabin khí vi mô. Proc. Asme/Igti Triển lãm Turbo GT - 2002 Từ 30082 (2002). ₂₁ K oser, H. & Lang, J. Mô hình mật độ công suất cao **MERS** Máy cảm ứng từ tính. Fennormore, A. M. (2001).Proc. Công nghệ nano MSM et al. Bộ truyền động quay dựa trên Őng nano carbon. tự nhiên 424 408 bóng410 (2003). ²³ Fan, D. L., Zhu, F. Q., Cammarata, R. C. & Dog, C. L. Vòng quay tốc độ cao có thể điều khiển của dây nano. Vật lý. Rev. Lett. 94 , 247208 (2005). 24 Ayari, A. et al. Turdoo. et al. Tự dao động trong các dây nano phát thải Bộ cộng hưởng cơ học: Một chuyển đổi DC-AC nanometric. Nano Lett. 7, 2252 Từ 2257 (2007). 25 Weldon, J. A., Alem Tiếtan, B., Sussman, A., Gannett, W. & Zettl, A. K. Tư dao động cơ học bền vững trong Óng nano carbon. 26 Ebefors, T. & Voice, G. Nano Lett. 10 , 1728 Từ 1733 (2010). Sổ tay MEMS: MEMS , chap. Microrobotics (CRC Press, Boca RA-Ứng dụng tấn, 2006). 27 Burg, T. P. et al. Cân của các phân tử sinh học, các tế bào đơn và các hạt nạno đơn trong uid. Thiên nhiên $\frac{446}{100}$, 1066 (2007). Bullis, W. M., Brewer, F. H., Kolstad, C. D. & Swartzen-Druber, L. J. Nhiệt đô hệ thống điện trở suất của SIL-Biểu tương và Germanium gần nhiệt độ phòng. Thử nghiệm rắn

11 , 639 Từ 646 (1968).

Điện tử